PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-164904

(43) Date of publication of application: 29.06.1993

(51)Int.CI.

G02B 3/00

(21)Application number: 03-337166

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

19.12.1991

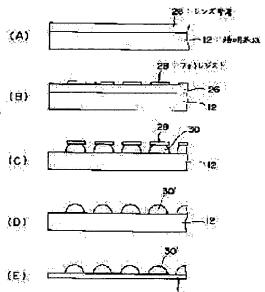
(72)Inventor: OKAMURA KOJI

TSUKAMOTO MAKOTO

(54) PRODUCTION OF MICROLENS ARRAY

(57) Abstract:

PURPOSE: To decrease the fluctuations in the quality of lenses and to facilitate production by forming lens elements on a transparent substrate in the specific production process. CONSTITUTION: A lens base layer 26 having the m. p. lower than the m.p. of the transparent substrate 12 is formed on this substrate in a 1st step. A photoresist 28 is formed on the parts to be left as the lens elements of the lens base layer 26 and the (B) lens base layer 26 is removed in a 2nd step. Then the plural lens elements 30 are formed to scatter on the transparent substrate 12. The lens elements 30 are heated at the temp, higher than the m.p. of the lens base layer 26 and lower than the m.p. of the transparent substrate 12 to melt the lens elements 30. Then, the surfaces of the molten lens elements 30 are made into smooth projecting surfaces. The lens elements 30 are cooled to establish the shape, by which the convex lenses 30' are formed on the transparent substrate 12 in a 4th step.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-164904

(43)公開日 平成5年(1993)6月29日

(51)Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 2 B 3/00

A 8106-2K

審査請求 未請求 請求項の数3(全 5 頁)

(21)出願番号	特願平3-337166	(71)出願人	000005223
			富士通株式会社
(22)出願日	平成3年(1991)12月19日		神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
		(72)発明者	岡村 浩司
			神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
			富士通株式会社内
		(72)発明者	塚本 誠
			神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
			富士通株式会社内
		(74)代理人	弁理士 松本 昂

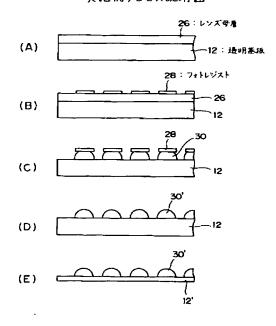
(54)【発明の名称】 マイクロレンズアレイの製造方法

(57)【要約】

【目的】本発明はマイクロレンズアレイの製造方法に関 し、レンズの品質ばらつきを小さくすること及び製造の 容易化を目的とする。

【構成】透明基板12上にこれよりも低融点のレンズ母 層26を形成するステップと、レンズ母層26をエッチ ングにより部分的に除去してレンズ要素30を形成する ステップと、レンズ要素30を加熱して溶融させるステ ップと、これを冷却するステップとから構成する。

実施例プロセス説明図



【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明基板(12)上に該透明基板の融点より も低い融点を有するレンズ母層(26)を形成する第1のス テップと、

1

該レンズ母層のレンズとなるべき部分を除き該レンズ母 層をエッチングにより除去してレンズ要素(30)を形成す る第2のステップと、

該レンズ要素を上記レンズ母層の融点よりも高く且つ上 記透明基板の融点よりも低い温度に加熱して、上記レン ズ要素(30)を溶融させる第3のステップと、

上記透明基板(12)及び溶融した上記レンズ要素 (30′) を冷却する第4のステップとを含むことを特徴とするマ イクロレンズアレイの製造方法。

【請求項2】 上記第1のステップは、原料ガス及び燃 料ガスが供給されるバーナ(6)の炎を上記透明基板(12) に対して走査して火炎加水分解により酸化物ガラススー トを上記基板(12)上に堆積させるステップを含むことを 特徴とする請求項1に記載のマイクロレンズアレイの製 造方法。

【請求項3】 上記透明基板(12)をエッチング又は研磨 20 により上記レンズ要素が形成されていない側から薄くす る第5のステップが付加的に備えられていることを特徴 とする請求項1又は2に記載のマイクロレンズアレイの 製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、微小な凸レンズを一般 的には複数備えてなるマイクロレンズアレイの製造方法 に関する。

【0002】尚、一般には複数のレンズを備えたものを 30 レンズアレイと称しているが、本発明方法は単一のレン ズを備えた物の製造にも適用可能であるから、本願明細 書においては、単一のレンズを備えた物もレンズアレイ の範疇に入るものとする。

【0003】光通信システム等における光回路の多チャ ンネル化、高機能化に対応して、複数の微小なレンズを 備えてなるマイクロレンズアレイが使用されるようにな ってきた。この種のマイクロレンズアレイは、例えば、 複数の光半導体素子(半導体レーザ等の発光素子或いは フォトダイオード等の受光素子)を配列してなる光半導 40 体アレイと、複数の光ファイバを配列してなる光ファイ パアレイとを光学的に結合するに際して使用され、レン ズ間のばらつきが小さく製造が容易なマイクロレンズア レイが要望されている。

[0004]

【従来の技術】従来、図4に示すように、例えばイオン 拡散法を用いて、多成分ガラスからなる基板2上の複数 箇所を高屈折率化して、複数のレンズ(凸レンズ)4を 形成するようにしたマイクロレンズアレイの製造方法が 知られている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、マイク ロレンズアレイの従来の製造方法による場合、レンズの 品質(例えば焦点距離)のばらつきが大きくなるという 問題があった。また、イオン拡散装置等の大規模な製造 装置が必要とされ、製造が容易でないという問題もあっ た。

【0006】本発明はこのような事情に鑑みて創作され たもので、レンズの品質ばらつきが小さく製造が容易な 10 マイクロレンズアレイの製造方法の提供を目的としてい る。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明のマイクロレンズ アレイの製造方法は、透明基板上に該透明基板の融点よ りも低い融点を有するレンズ母層を形成する第1のステ ップと、該レンズ母層のレンズとなるべき部分を除き該 レンズ母層をエッチングにより除去してレンズ要素を形 成する第2のステップと、該レンズ要素を上記レンズ母 層の融点よりも高く且つ上記透明基板の融点よりも低い 温度に加熱して、上記レンズ要素を溶融させる第3のス テップと、上記透明基板及び溶融した上記レンズ要素を 冷却する第4のステップとを含む。

[0008]

【作用】第1のステップでは、透明基板上にこれよりも 低融点なレンズ母層が形成される。このレンズ母層は、 第2のステップで、レンズとなるべき部分を除いてエッ チングにより除去されて、一般的には複数のレンズ要素 が透明基板上に形成される。これらレンズ要素は互いに 接触しておらず、透明基板上に点在しているものであ る。レンズ要素は単一であってもよい。

【0009】第3のステップでレンズ要素を加熱して溶 融させると、その表面張力によって、溶融したレンズ要 素の表面は滑らかな凸面となる。これを第4のステップ で冷却すると、その形状が確定して基板上に凸レンズが 得られる。

【0010】尚、本発明方法において、透明基板よりも 低融点なレンズ母層を形成しているのは、第3のステッ プでレンズ要素のみを溶融させて、透明基板が変形する ことを防止するためである。

[0011]

【実施例】以下本発明の実施例を説明する。図1は本発 明を実施するにあたりレンズ母層の形成に使用すること ができるガラススート堆積装置の構成図である。6は原 料ガス並びに燃焼用の酸素及び水素が供給されるバーナ であり、このバーナ6は、X軸駆動装置8によって図中 の左右方向に等速度(例えば100mm/秒)で往復走査 される。

【0012】10はその上に透明基板12が載置される ステージであり、このステージ10は、Y軸駆動装置1 50 4によって紙面の表面側から裏面側に向かう方向或いは

これとは逆の方向に等速度(例えば1mm/秒)で往復動 作する。透明基板12はその上にレンズ母層を形成する ためのものであり、この実施例では、石英ガラス平板か らなる基板が使用される。

【0013】16は燃焼制御装置であり、酸素及び水素 を所定の混合比で混合して所定の流量でバーナ6に供給 する。18は使用される原料ガスの種類に応じて複数設 けられた原料ガス供給装置であり、これら原料ガス供給 装置18は、ガスフローメータ20からそれぞれ送り込 まれる酸素等のキャリアガスの流量に応じて原料ガスを 10 送り出す。

【0014】図示された例では、原料ガス供給装置18 には原料ガスが液相で充填されているが、気相の原料ガ スを用いて、その流量を直接ガスフローメータで調整す るようにしてもよい。22は混合された原料ガスの総流 量を制御するためのガスフローメータである。

【0015】との実施例では、各原料ガス供給装置18 には、それぞれ、レンズ母層の主成分となるSiO。を 得るためのSiCl、と、P、O、を得るためのPOC 1, と、B、O, を得るためのBBr, とが充填されて 20 いる。ドーパントとしてのP、O、及びB、O、はレン ズ母層の融点及び屈折率を調整するためのものである。 【0016】バーナ6から吹き出された原料ガスは、燃 焼に伴う火炎加水分解によりSiO、等の酸化物とな り、この酸化物は白色粉末状の酸化物ガラススート24 として透明基板12上に堆積される。

【0017】バーナ6の走査及びステージ10の移動に よって、透明基板12上には均一の厚みで酸化物ガラス スート24が堆積される。透明基板12上に堆積した酸 化物ガラススート24は、例えば電気炉内において加熱 30 することによってガラス化することができる。

【0018】図2は本実施例におけるマイクロレンズア レイの製造プロセスの説明図である。まず、図1の装置 を用いて透明基板12上に酸化物ガラススート24を堆 積させ、この酸化物ガラススートを加熱してガラス化す ることによって、図2(A)に示すように、均一厚みの レンズ母層26を得る。酸化物ガラススートの組成は、 その融点が透明基板12の融点よりも十分低くなるよう に原料ガスの組成等によって調整されている。透明基板 は約50μmである。

【0019】次いで、図2 (B)に示すように、レンズ 母層26のレンズ要素として残すべき部分の上にフォト レジスト28を形成する。フォトレジスト28は、例え ば図3に示すようなマスクバターンを用いて通常の方法 により形成することができる。

【0020】図3(A)に示したマスクパターンは、マ スクフィルム30に複数の正方形のパターン30Aを等 間隔で一列に配列したものである。バターン30Aの一 0 μ m であり、パターン3 0 A の個数は例えば5 0 であ る。

【0021】図3(B)に示したマスクパターンは、マ スクフィルム30に複数の円形のパターン30Bを等間 隔で一列に形成したものである。また、図3(C)に示 したマスクパターンは、マスクフィルム30に複数の正 方形のパターン30Cを等間隔で二次元的に形成したも のである。

【0022】レンズ母層26上にフォトレジスト28を 形成したならば、フッ酸及び硫酸の混合液をエッチング 剤としてレンズ母層26についてエッチングを行い、図 2 (C) に示すように、レンズ母層の不要部分を除去し てレンズ要素30を形成する。ここで、各レンズ要素3 0の側面が湾曲しているのは、オーバーエッチングによ

【0023】その後、フォトレジスト28を除去して、 透明基板12を加熱炉内で約1300℃に加熱する。と の温度では透明基板12は殆ど変形しないが、各レンズ 要素30は溶融し、図2(D)に30′で示すように、 表面張力によって滑らかな凸面を有するようになる。

【0024】そして、透明基板12及び溶融したレンズ 要素30′を徐冷することによって、レンズ要素30′ の形状は確定する。以下、この形状が確定したレンズ要 素をレンズ30′と称する。

【0025】最後に、レンズ30′が形成された透明基 板12を樹脂中に埋め込み、透明基板12のレンズ3 0′が形成されている側の面とは反対側の面を研磨した 後、樹脂を取り去り、図2(E)に示すように、例えば 約0.2 mmにまで薄くなった透明基板12′を得る。 尚、研磨によらず、エッチングによって透明基板を薄く してもよい。

【0026】このように透明基板を薄くしているのは、 レンズ30′を用いて光ファイバと光半導体素子とを光 結合するに際して、光ファイバと光半導体素子の位置関 係の制限を少なくするためである。

【0027】本実施例によると、図1に示した装置を用 いて組成が極めて均一なレンズ母層26を形成している ので、各レンズ要素30の組成についてもばらつきが極 めて小さくなり、従って、各レンズ要素を溶融したとき 12の厚みは例えば約0.8mm、レンズ母層26の厚み 40 に均一な表面張力を生じさせて、レンズ30′の形状の ばらつきを小さくすることができる。

> 【0028】また、フォトレジスト28の寸法精度は良 好であるから、一定形状のレンズを得ることができると ともに、イオン拡散法による従来方法による場合と比較 してレンズピッチを小さく且つ正確に設定することがで きる。

【0029】さらに、図3で説明したように、選択する マスクパターンに応じてレンズの所望の配列パターンを 容易に得ることができる。本実施例によりマイクロレン 辺の長さ及びピッチはそれぞれ例えば400μm, 50 50 ズアレイを製造したところ、そのレンズを用いて半導体 5

レーザから開口角20°で放射された光を良好にコリメートすることができた。このときのレンズと半導体レーザの出射端面の間隔は約0.1mmであった。

【0030】尚、本実施例においては、透明基板上に形成した酸化物ガラススートを一旦加熱してガラス化した後にレンズ要素を得るようにしているが、これはフォトレジストとレンズ母層の密着性を良好にするためである。従って、適当なフォトレジストを用いて、酸化物ガラススートをレンズ母層として直接レンズ要素を形成するようにしてもよい。

【0031】本発明を実施する場合、レンズ母層の形成にゾルゲル法を採用することもできる。即ち、透明基板上に変性アルキルシリケート溶液を塗布し、これを加熱することによって均一厚みのレンズ母層を得ることができる。変性アルキルシリケート溶液としては、有限会社テー・エス・ビー開発センター製の無機コーティング材料ETSB-6000、ETSB-7000或いはグラスモドキ(登録商標)、X-500PAをメタノール等のアルコール系溶媒に溶解させたものを使用することができる。

【0032】このように本発明を実施する場合には、イオン拡散装置等の大規模な製造装置が不要であり、簡単*

* なプロセスでマイクロレンズアレイを製造することができる。

[0033]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によると、 レンズの品質ばらつきが小さく製造が容易なマイクロレ ンズアレイの製造方法の提供が可能になるという効果を 奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を実施するに際してレンズ母層の形成に 10 使用することができるガラススート堆積装置の構成図で ホス

【図2】本発明の実施例を示すマイクロレンズアレイの 製造プロセスの説明図である。

【図3】本発明の実施例において使用することができるマスクパターンの例を示す図である。

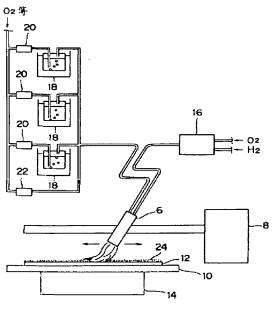
【図4】従来技術の説明図である。

【符号の説明】

- 12 透明基板
- 26 レンズ母層
- 20 30 レンズ要素
 - 30′ 溶融したレンズ要素又はレンズ

【図1】

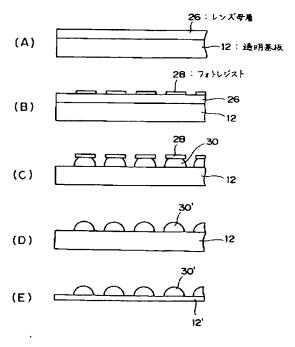
かラススート堆積装置の構成図



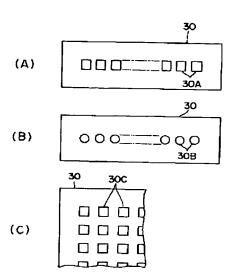
12: 透明基板

[図2]

実施例プロセス説明図



【図3】 マスクパターンの例を示す図



【図4】

従来技術の説明図

